



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0047614
(43) 공개일자 2018년05월10일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G02F 1/1368 (2006.01) *G02F 1/1343* (2006.01)
G02F 1/1362 (2006.01) *H01L 29/786* (2006.01)
 (52) CPC특허분류
G02F 1/1368 (2013.01)
G02F 1/134309 (2013.01)
 (21) 출원번호 10-2016-0143998
 (22) 출원일자 2016년10월31일
 심사청구일자 없음

(71) 출원인
엘지디스플레이 주식회사
 서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)
 (72) 발명자
김원두
 경기도 고양시 일산서구 대산로 53 (주엽동, 강선마을4단지아파트) 404동 803호
김가경
 경기도 고양시 일산서구 후곡로 12 (일산동, 후곡마을9단지) LG롯데아파트 908동 1003호
 (74) 대리인
특허법인로얄

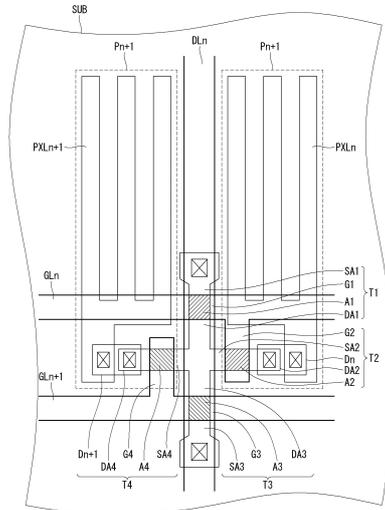
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **초고 해상도 액정 표시장치**

(57) 요약

본 발명은 화소당 보상용 박막 트랜지스터를 더 구비한 초고 해상도 액정 표시장치에 관한 것이다. 본 발명에 의한 초고 해상도 액정 표시장치는, 제1 게이트 배선, 제2 게이트 배선, 데이터 배선, 제2 게이트 전극, 제4 게이트 전극, 십자형 반도체 층, 제1 화소 전극 및 제2 화소 전극을 포함한다. 제1 게이트 배선과 제2 게이트 배선은 서로 이웃하여 배치된다. 데이터 배선은, 제1 게이트 배선 및 상기 제2 게이트 배선과 교차한다. 십자형 반도체 층은, 수직부 및 수평부를 포함한다. 수직부는, 제1 게이트 배선 상부에서 제2 게이트 배선의 하부까지 연장된다. 수평부는, 수직부의 중앙에서 분기하여 제1 게이트 전극 및 제2 게이트 전극을 가로질러 연장된다.

대표도 - 도6



(52) CPC특허분류

G02F 1/13624 (2013.01)

G02F 1/136286 (2013.01)

H01L 29/786 (2013.01)

G02F 2201/123 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

이웃하는 제1 게이트 배선과 제2 게이트 배선;
상기 제1 게이트 배선 및 상기 제2 게이트 배선과 교차하는 데이터 배선;
상기 제1 게이트 배선에서 상기 데이터 배선과 평행하게, 상기 제2 게이트 배선쪽으로 분기된 제2 게이트 전극;
상기 제2 게이트 배선에서 상기 데이터 배선과 평행하게, 상기 제1 게이트 배선쪽으로 분기된 제4 게이트 전극;
상기 제1 게이트 배선 상부에서 상기 제2 게이트 배선의 하부까지 연장된 수직부, 그리고 상기 수직부의 중앙에서 분기하여 상기 제2 게이트 전극 및 상기 제4 게이트 전극을 가로질러 연장된 수평부를 포함하는 십자형 반도체 층;
상기 데이터 배선의 일측면에 배치된 제1 화소 전극;
상기 데이터 배선의 타측면에 배치된 제2 화소 전극을 포함하는 액정 표시장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,
상기 수직부는,
상기 제1 게이트 배선을 가로지르는 제1 수직부; 그리고
상기 제2 게이트 배선을 가로지르는 제2 수직부를 포함하고,
상기 수평부는,
상기 제2 게이트 전극을 가로지르는 제1 수평부; 그리고
상기 제4 게이트 전극을 가로지르는 제2 수평부를 포함하는 액정 표시장치.

청구항 3

제 2 항에 있어서,
상기 제1 수직부를 포함하는 제1 박막 트랜지스터;
상기 제1 수평부를 포함하는 제2 박막 트랜지스터;
상기 제2 수직부를 포함하는 제3 박막 트랜지스터; 그리고
상기 제2 수평부를 포함하는 제4 박막 트랜지스터를 구비하는 액정 표시장치.

청구항 4

제 3 항에 있어서,
상기 제1 박막 트랜지스터와 상기 제2 박막 트랜지스터는, 서로 직렬로 연결되어 상기 제1 화소 전극에 연결되며,
상기 제3 박막 트랜지스터와 상기 제4 박막 트랜지스터는, 서로 직렬로 연결되어 상기 제2 화소 전극에 연결된

액정 표시장치.

청구항 5

제 3 항에 있어서,
상기 제1 박막 트랜지스터는,
상기 제1 게이트 배선의 상부에서 상기 데이터 배선과 연결된 제1 소스 영역;
상기 제1 게이트 배선의 일부인 제1 게이트 전극;
상기 제1 수직부에서 상기 제1 게이트 전극과 중첩하는 제1 채널 영역; 그리고
상기 제1 게이트 배선의 하부로 상기 제1 채널 영역에서 연장된 제1 드레인 영역을 포함하는 액정 표시장치.

청구항 6

제 5 항에 있어서,
상기 제2 박막 트랜지스터는,
상기 제1 드레인 영역에서 수평 방향으로 연장된 제2 소스 영역;
상기 제2 게이트 전극;
상기 제1 수평부에서 상기 제2 게이트 전극과 중첩하는 제2 채널 영역;
상기 제2 채널 영역에서 상기 제2 소스 영역과 대향하여 연장된 제2 드레인 영역; 그리고
상기 제2 드레인 영역 및 상기 제1 화소 전극과 연결된 제1 드레인 전극을 포함하는 액정 표시장치.

청구항 7

제 3 항에 있어서,
상기 제3 박막 트랜지스터는,
상기 제2 게이트 배선의 하부에서 상기 데이터 배선과 연결된 제3 소스 영역;
상기 제2 게이트 배선의 일부인 제3 게이트 전극;
상기 제2 수직부에서 상기 제3 게이트 전극과 중첩하는 제3 채널 영역; 그리고
상기 제2 게이트 배선의 상부로 상기 제3 채널 영역에서 연장된 제3 드레인 영역을 포함하는 액정 표시장치.

청구항 8

제 7 항에 있어서,
상기 제4 박막 트랜지스터는,
상기 제3 드레인 영역에서 수평 방향으로 연장된 제4 소스 영역;
상기 제4 게이트 전극;
상기 제2 수평부에서 상기 제4 게이트 전극과 중첩하는 제4 채널 영역;
상기 제4 채널 영역에서 상기 제4 소스 영역과 대향하여 연장된 제4 드레인 영역; 그리고

상기 제4 드레인 영역 및 상기 제2 화소 전극과 연결된 제2 드레인 전극을 포함하는 액정 표시장치.

청구항 9

제 1 항에 있어서,
 상기 수직부는,
 상기 데이터 배선과 중첩하여 배치되며,
 양 끝단부 각각이 상기 데이터 배선과 연결된 액정 표시장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 화소당 보상용 박막 트랜지스터를 더 구비한 초고 해상도 액정 표시장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 화소 구동용 박막 트랜지스터의 온/오프 특성을 보상하기 위한 보상용 박막 트랜지스터를 더 구비한 초고 해상도 액정 표시장치에서 고 개구율을 구현하기 위한 화소 구조에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 정보화 사회가 발전함에 따라 화상을 표시하기 위한 표시장치에 대한 요구가 다양한 형태로 증가하고 있다. 이에 따라, 부피가 큰 음극선관(Cathode Ray Tube: CRT)을 대체하는, 얇고 가벼우며 대면적이 가능한 평판 표시장치(Flat Panel Display Device: FPD)로 급속히 발전해 왔다. 평판 표시장치에는 액정표시장치(Liquid Crystal Display Device: LCD), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel: PDP), 유기발광 표시장치(Organic Light Emitting Display Device: OLED), 그리고 전기영동 표시장치(Electrophoretic Display Device: ED)와 같은 다양한 평판표시장치가 개발되어 활용되고 있다.

[0003] 평판표시장치를 구성하는 표시패널(DP)은 매트릭스 방식으로 배열된 화소 영역 내에 할당된 박막 트랜지스터가 배치된 박막 트랜지스터 기관을 포함한다. 예를 들어, 액정표시장치(Liquid Crystal Display Device: LCD)는 전계를 이용하여 액정의 광투과율을 조절함으로써 화상을 표시한다. 이러한 액정표시장치는 액정을 구동시키는 전계의 방향에 따라 수직 전계형과 수평 전계형으로 구분한다.

[0004] 수직 전계형 액정표시장치는 상 하부 기관에 대향하게 배치된 화소 전극과 공통전극 사이에 형성되는 수직 전계에 의해 TN(Twisted Nematic) 모드의 액정을 구동한다. 이러한 수직전계형 액정표시장치는 개구율이 큰 장점을 가지는 반면, 시야각이 90도 정도로 좁은 단점이 있다.

[0005] 수평 전계형 액정표시장치는 하부 기관에 평행하게 배치된 화소 전극과 공통전극 사이에 수평 전계를 형성하여 인 플레인 스위칭(In Plane Switching: IPS) 모드의 액정을 구동한다. 이러한 IPS 모드의 액정표시장치는 시야각이 160도 정도로 넓은 장점이 있으나, 개구율 및 투과율이 낮은 단점이 있다. 구체적으로 IPS 모드의 액정표시장치는 인 플레인 필드(In Plane Field)를 형성하기 위해서 공통전극과 화소전극간의 간격을 상 하부 기관의 간격보다 넓게 형성하고, 적절한 세기의 전계를 얻기 위해서 공통전극과 화소 전극을 일정한 너비를 갖는 띠 형태로 형성한다. 이와 같은 IPS 모드의 화소 전극 및 공통전극 사이에는 기관과 거의 평행한 전계가 형성되지만, 너비를 갖는 화소 전극 및 공통전극들 상부의 액정에는 전계가 형성되지 않는다. 즉, 화소 전극 및 공통전극 상부에 놓인 액정분자들은 구동되지 않고 초기 배열 상태를 유지한다. 초기상태를 유지하는 액정은 광을 투과시키지 못하여 개구율 및 투과율을 저하하는 요인이 된다.

[0006] 이러한 IPS 모드의 액정표시장치의 단점을 개선하기 위해 프린지 필드(Fringe Field)에 의해 동작하는 프린지 필드 스위칭(Fringe Field Switching: FFS) 방식의 액정표시장치가 제안되었다. FFS 타입의 액정표시장치는 각 화소 영역에 절연막을 사이에 둔 공통전극과 화소 전극을 구비하고, 그 공통전극과 화소 전극의 간격을 상 하부 기관의 간격보다 좁게 형성하여 공통전극과 화소 전극 상부에 포물선 형태의 프린지 필드를 형성하도록 만든다. 프린지 필드에 의해 상 하부 기관 사이에 개재된 액정 분자들은 모두 동작함으로써 개구율 및 투과율이 향상된 결과를 얻을 수 있다.

[0007] 도 1은 종래의 프린지 필드 방식의 액정표시장치에 포함된 산화물 반도체 층을 갖는 평판형 표시패널을 구성하는 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor: TFT) 기관을 나타내는 평면도이다. 도 2는 도 1에 도시한 평판표시

장치의 박막 트랜지스터 기판에서 절취선 I-I'선을 따라 자른 단면도이다.

- [0008] 도 1 및 도 2에 도시된 박막 트랜지스터 기판은 하부 기판(SUB) 위에 게이트 절연막(GI)을 사이에 두고 교차하는 게이트 배선(GL) 및 데이터 배선(DL)과, 그 교차부마다 형성된 박막 트랜지스터(T)를 구비한다. 그리고 게이트 배선(GL)과 데이터 배선(DL)의 교차 구조에 의해 화소 영역이 정의된다. 이 화소 영역에는 프린지 필드를 형성하도록 제2 보호막(PAS2)을 사이에 두고 형성된 화소 전극(PXL)과 공통전극(COM)을 구비한다. 화소 전극(PXL)은 화소 영역에 대응하는 대략 장방형의 모양을 갖고, 공통전극(COM)은 평행한 다수 개의 띠 모양으로 형성할 수 있다.
- [0009] 공통전극(COM)은 게이트 배선과 나란하게 배열된 공통 배선(CL)과 접속된다. 공통전극(COM)은 공통 배선(CL)을 통해 액정 구동을 위한 기준 전압(혹은 공통 전압)을 공급받는다.
- [0010] 박막 트랜지스터(T)는 게이트 배선(GL)의 게이트 신호에 응답하여 데이터 배선(DL)의 화소 신호가 화소 전극(PXL)에 충전되어 유지하도록 한다. 이를 위해, 박막 트랜지스터(T)는 게이트 배선(GL)에서 분기된 게이트 전극(G), 데이터 배선(DL)에서 분기된 소스 전극(S), 소스 전극(S)과 대향하며 화소 전극(PXL)과 접속된 드레인 전극(D), 그리고 게이트 절연막(GI) 위에서 게이트 전극(G)과 중첩하며 소스 전극(S)과 드레인 전극(D) 사이에 채널을 형성하는 반도체 채널 층(A)을 포함한다.
- [0011] 특히, 반도체 층(SE)은 다결정 실리콘(Poly-Silicon) 물질로 형성하는 데, 게이트 전극(G)과 동일한 모양으로 중첩하는 다결정 실리콘 물질이 반도체 채널 층(A)으로 정의된다. 그리고 다결정 실리콘 물질 중 반도체 채널 층(A) 영역을 제외한 부분은 플라즈마 처리로 도체화되어 소스 콘택홀(SH)과 드레인 콘택홀(DH)을 통해 각각 소스 전극(S) 및 드레인 전극(D)과 접촉된다. 즉, 다결정 실리콘 반도체 층(SE)은 소스 전극(S)과 접촉하는 소스 영역(SA), 드레인 전극(D)과 접촉하는 드레인 영역(DA), 그리고 소스 영역(SA)과 드레인 영역(DA) 사이에서 게이트 전극(G)과 완전히 중첩하는 반도체 채널 층(A)으로 구분된다.
- [0012] 프린지 필드 스위칭 방식에서는 화소 전극(PXL)과 공통 전극(COM)이 중첩하는 구조를 갖는다. 이 중첩한 영역에서 보조 용량이 형성된다. 프린지 필드를 구성하고, 보조 용량을 충분히 충전하기 위해서는 고 용량의 박막 트랜지스터를 필요로 한다. 따라서, 프린지 필드 방식에서는 탑 게이트(Top Gate) 구조를 갖는 다결정 실리콘 반도체 물질을 포함하는 박막 트랜지스터를 사용하는 것이 바람직하다.
- [0013] 도 2를 더 참조하여, 탑 게이트 구조를 갖는 다결정 실리콘 반도체 물질을 포함하는 박막 트랜지스터의 구조를 설명한다. 기판(SUB) 위에서 반도체 층(SE)이 먼저 형성된다. 반도체 층(SE) 위에, 게이트 절연막(GI)이 전면 도포된다. 게이트 절연막(GI) 위에서 반도체 층(SE)의 중앙부인 반도체 채널 층(A)과 중첩하는 게이트 전극(G)이 형성된다.
- [0014] 게이트 전극(G) 위에는 기판(SUB) 전체를 덮는 중간 절연막(IN)이 도포된다. 중간 절연막(IN) 및 게이트 절연막(GI)을 관통하여 반도체 층(SE)의 소스 영역(SA)과 드레인 영역(DA)을 개방하는 소스 콘택홀(SH) 및 드레인 콘택홀(DH)이 형성된다. 그리고 중간 절연막(IN) 위에는 소스 콘택홀(SH)을 통해 소스 영역(SA)과 접촉하는 소스 전극(S) 및 드레인 콘택홀(DH)을 통해 드레인 영역(DA)과 접촉하는 드레인 전극(D)이 형성된다.
- [0015] 이와 같이 형성된 탑 게이트 형 박막 트랜지스터(T)가 형성된 기판(SUB) 위의 전체 면에는 제1 보호막(PAS1)이 도포된다. 그리고 제1 보호막(PAS1)을 관통하여 드레인 전극(D)의 일부를 노출하는 화소 콘택홀(PH)이 형성된다.
- [0016] 화소 전극(PXL)은 제1 보호막(PAS1) 위에서 화소 콘택홀(PH)을 통해 드레인 전극(D)과 접속한다. 한편, 공통전극(COM)은 화소 전극(PXL)을 덮는 제2 보호막(PAS2)을 사이에 두고 화소 전극(PXL)과 중첩되게 형성된다. 이와 같은 화소 전극(PXL)과 공통 전극(COM) 사이에서 프린지 필드형 전계를 형성한다. 또한, 화소 전극(PXL)과 공통 전극(COM)이 중첩된 영역에서는 보조 용량이 형성된다. 프린지 필드형 전계에 의해 박막 트랜지스터 기판과 컬러 필터 기판 사이에서 수평 방향으로 배열된 액정분자들이 유전 이방성에 의해 회전한다. 그리고 액정 분자들의 회전 정도에 따라 화소 영역을 투과하는 광 투과율이 달라져 계조를 구현한다.
- [0017] 다결정 실리콘 반도체 물질을 포함하는 박막 트랜지스터의 특성상 오프 전류(Off-Current) 특성을 열화되는 문제가 있다. 구동 박막 트랜지스터에서 열화된 오프 특성을 보상하기 위해서는 보상용 박막 트랜지스터를 더 구비하는 것이 필요하다.
- [0018] 이하, 도 3을 참조하여, 보상용 박막 트랜지스터를 더 구비한 액정 표시장치의 경우를 설명한다. 도 3은 종래 기술에 의한 보상 박막 트랜지스터를 구비한 액정 표시장치용 박막 트랜지스터 기판을 나타내는 평면도이다.

- [0019] 보상용 박막 트랜지스터를 더 구비한 종래 기술에 의한 박막 트랜지스터 기판은 하부 기판(SUB) 위에 게이트 절연막(GI)을 사이에 두고 교차하는 게이트 배선(GL) 및 데이터 배선(DL)에 의해 화소 영역이 정의된다. 화소 영역에는 프린지 필드를 형성하도록 제2 보호막(PAS2)을 사이에 두고 형성된 화소 전극(PXL)과 공통전극(COM)을 구비한다. 화소 전극(PXL)은 화소 영역에 대응하는 대략 장방형의 모양을 갖고, 공통전극(COM)은 평행한 다수 개의 띠 모양으로 형성할 수 있다.
- [0020] 각 화소 영역에는 박막 트랜지스터(T1)가 하나씩 배치된다. 또한, 박막 트랜지스터(T1)에는 오프-전류 특성을 보완하기 위한 보상 박막 트랜지스터(T2)가 배치된다. 박막 트랜지스터(T1)의 드레인 전극(D1)은 보상 박막 트랜지스터(T2)의 소스 전극(S2)과 연결된다.
- [0021] 직렬로 연결된 박막 트랜지스터(T1)와 보상 박막 트랜지스터(T2)를 포함하는 박막 트랜지스터 기판의 구조를 좀 더 구체적으로 설명한다. 기판(SUB) 위에 가로 방향으로 진행되는 게이트 배선(GL)들과 세로 방향으로 진행되는 데이터 배선(DL)들이 교차하는 구조로 매트릭스 방식의 화소 영역이 정의된다.
- [0022] 박막 트랜지스터(T1)의 제1 게이트 전극(G1)은 게이트 배선(GL)에서 화소 영역의 반대 쪽으로 분기한 구조를 갖는다. 박막 트랜지스터(T1)의 제1 소스 전극(S1)은 데이터 배선(DL)에서 화소 영역으로, 특히 제1 게이트 전극(G1)을 향해 분기한 구조를 갖는다. 박막 트랜지스터(T1)의 반도체 층(SE)은 제1 소스 전극(S1)에 연결되고, 제1 게이트 전극(G1)을 가로질러 연장된다. 박막 트랜지스터(T1)의 제1 드레인 전극(D1)은 별도의 전극으로 형성하지 않고, 제1 소스 전극(S1)과 접촉하는 반도체 층(SE)의 제1 소스 영역(SA1)에서 연장되어 제1 게이트 전극(G1)을 중심으로 대향하는 영역인 제1 드레인 영역(DA1)이 제1 드레인 전극(D1)이 된다.
- [0023] 보상 박막 트랜지스터(T2)의 제2 게이트 전극(G2)은 별도로 형성하지 않고, 게이트 배선(DL)의 일부분을 제2 게이트 전극(G2)으로 사용한다. 보상 박막 트랜지스터(T2)의 제2 소스 전극(S2)도 별도로 형성하지 않고, 반도체 층(SE)의 제1 드레인 영역(DA1)에서 연장된 영역인 제2 소스 영역(SA2)을 제2 소스 전극(S2)으로 사용한다. 보상 박막 트랜지스터(T2)의 제2 드레인 전극(D2)은 반도체 층(SE)에서 연장되어 제2 게이트 전극(G2)을 중심으로 제2 소스 영역(SA2)과 대향하는 영역인 제2 드레인 영역(DA2)에 연결된다.
- [0024] 박막 트랜지스터(T1)와 보상 박막 트랜지스터(T2)를 직렬로 연결하기 위해서, 박막 트랜지스터(T1)의 제1 게이트 전극(G1)은 해당 화소의 아래에 배치된 화소 영역으로 돌출된 구조를 갖는다. 그리고 반도체 층(SE)은 아래 화소 영역에서 제1 게이트 전극(G1)과 중첩한 후, 연속해서 게이트 배선(GL)과 중첩하고, 해당 화소 영역 내까지 연장되도록 배치된다. 보상 박막 트랜지스터(T2)의 제2 드레인 전극(D2)은 화소 영역 내에 형성된 화소 전극(PXL)과 연결된다.
- [0025] 화소 전극(PXL)은 보호막을 사이에 두고 공통 전극(COM)과 중첩하는 구조를 갖는다. 공통전극(COM)은 게이트 배선(GL)과 나란하게 배열된 공통 배선(CL)과 접촉된다. 공통전극(COM)은 공통 배선(CL)을 통해 액정 구동을 위한 기준 전압(혹은 공통 전압)을 공급받는다. 이와 같은 화소 전극(PXL)과 공통 전극(COM) 사이에서 프린지 필드형 전계를 형성한다. 또한, 화소 전극(PXL)과 공통 전극(COM)이 중첩된 영역에서는 보조 용량이 형성된다. 프린지 필드형 전계에 의해 박막 트랜지스터 기판과 컬러 필터 기판 사이에서 수평 방향으로 배열된 액정분자들이 유전 이방성에 의해 회전한다. 그리고 액정 분자들의 회전 정도에 따라 화소 영역을 투과하는 광 투과율이 달라져 계조를 구현한다.
- [0026] 300PPI 정도의 해상도 액정 표시장치에서는 화소 영역의 크기가 큰 편이어서, 박막 트랜지스터(T1)와 보상 박막 트랜지스터(T2)가 화소 영역에서 차지하는 비율이 그리 크지 않다. 특히, 보조 용량을 따로 구성하지 않고, 화소 전극(PXL)과 공통 전극(COM)이 중첩되어 보조 용량을 형성하는 프린지 필드 스위칭 방식의 액정 표시장치에서는 개구 영역이 충분히 확보된다. 따라서, 보상 박막 트랜지스터(T2)의 크기로 인해 줄어드는 개구 영역의 비율이 크게 문제되지 않는다.
- [0027] 보상 박막 트랜지스터를 더 구비한 구조를 300PPI 정도의 해상도용 액정 표시장치에 적용하기 위해, 도 3에 도시한 바와 같이, 보상 박막 트랜지스터(T2)의 제2 게이트 전극(G2)을 별도로 형성하지 않고 게이트 배선(GL)을 이용하여 구성하였다. 그 결과, 박막 트랜지스터(T1)와 보상 박막 트랜지스터(T2)가 화소 영역에서 차지하는 면적을 어느 정도 줄일 수 있었다. 이러한 구조에서는, 300PPI 전후의 해상도에서는 어느 정도 개구율을 확보할 수 있지만, 300PPI 이상의 고 해상도 액정 표시장치에서는 좀 더 개구율을 확보할 필요성이 있다.
- [0028] 300PPI 이상의 고 해상도 혹은 500PPI 이상의 초고 해상도용 액정 표시장치에서는 화소 영역의 크기가 이보다 낮은 해상도에 비해서 확연히 줄어든다. 반면에, 박막 트랜지스터들(T1, T2)의 크기는, 특성을 유지하기 위해서는, 줄어드는 화소 영역에 비례하여 줄인 크기를 가질 수 없다. 즉, 고 해상도 혹은 초고 해상도를 구현하

기 위한 화소 구조에서는, 화소 면적에서 박막 트랜지스터들(T1, T2) 차지하는 면적 비율이 점점 커진다. 박막 트랜지스터들(T1, T2)이 차지하는 영역은 비 투과 영역이므로, 고 해상도 및 초고 해상도에서는 개구율 감소에 중요한 원인이 된다. 300PPI 이상의 고 해상도 혹은 500PPI 이상의 초고 해상도용 액정 표시장치를 위한 박막 트랜지스터 기판은 화소 면적당 개구 영역의 비율을 좀 더 높일 수 있는 새로운 구조가 절실히 요구되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0029] 본 발명의 목적은, 상기 종래 기술에 의한 문제점을 극복하기 위한 것으로서, 다결정 실리콘 반도체 물질을 구비한 박막 트랜지스터의 오프-전류 특성을 보완하기 위한 보상 박막 트랜지스터를 구비한 액정 표시장치를 제공하는 데 있다. 특히, 본 발명은 500PPI(Pixel Per Inch) 이상의 초고 해상도를 구현하고, 다결정 실리콘 반도체 층을 갖는 보상 박막 트랜지스터를 구비하고, 고 개구율을 확보하기 위한 화소 구조를 갖는 액정 표시장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0030] 상기 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 의한 초고 해상도 액정 표시장치는, 제1 게이트 배선, 제2 게이트 배선, 데이터 배선, 제2 게이트 전극, 제4 게이트 전극, 십자형 반도체 층, 제1 화소 전극 및 제2 화소 전극을 포함한다. 제1 게이트 배선과 제2 게이트 배선은 서로 이웃하여 배치된다. 데이터 배선은, 제1 게이트 배선 및 상기 제2 게이트 배선과 교차한다. 제2 게이트 전극은, 제1 게이트 배선에서 데이터 배선과 평행하게, 제2 게이트 배선쪽으로 분기된다. 제4 게이트 전극은, 제2 게이트 배선에서 데이터 배선과 평행하게, 제1 게이트 배선쪽으로 분기된다. 십자형 반도체 층은, 수직부 및 수평부를 포함한다. 수직부는, 제1 게이트 배선 상부에서 제2 게이트 배선의 하부까지 연장된다. 수평부는, 수직부의 중앙에서 분기하여 제2 게이트 전극 및 제4 게이트 전극을 가로질러 연장된다. 제1 화소 전극은, 데이터 배선의 일측면에 배치된다. 제2 화소 전극은, 데이터 배선의 타측면에 배치된다.

[0031] 일례로, 수직부는, 제1 게이트 배선을 가로지르는 제1 수직부와, 제2 게이트 배선을 가로지르는 제2 수직부를 포함한다. 수평부는, 제2 게이트 전극을 가로지르는 제1 수평부와, 제4 게이트 전극을 가로지르는 제2 수평부를 포함한다.

[0032] 일례로, 제1 수직부를 포함하는 제1 박막 트랜지스터, 제1 수평부를 포함하는 제2 박막 트랜지스터, 제2 수직부를 포함하는 제3 박막 트랜지스터, 그리고 제2 수평부를 포함하는 제4 박막 트랜지스터를 구비한다.

[0033] 일례로, 제1 박막 트랜지스터와 제2 박막 트랜지스터는, 서로 직렬로 연결되어 제1 화소 전극에 연결된다. 제3 박막 트랜지스터와 제4 박막 트랜지스터는, 서로 직렬로 연결되어 제2 화소 전극에 연결된다.

[0034] 일례로, 제1 박막 트랜지스터는, 제1 소스 영역, 제1 게이트 전극, 제1 채널 영역 및 제1 드레인 영역을 포함한다. 제1 소스 영역은, 제1 게이트 배선의 상부에서 데이터 배선과 연결된다. 제1 게이트 전극은, 제1 게이트 배선의 일부이다. 제1 채널 영역은, 제1 수직부에서 제1 게이트 전극과 중첩한다. 제1 드레인 영역은, 제1 게이트 배선의 하부로 제1 채널 영역에서 연장된다.

[0035] 일례로, 제2 박막 트랜지스터는, 제2 소스 영역, 제2 게이트 전극, 제2 채널 영역, 제2 드레인 영역 및 제1 드레인 전극을 포함한다. 제2 소스 영역은, 제1 드레인 영역에서 수평 방향으로 연장된다. 제2 채널 영역은, 제1 수평부에서 제2 게이트 전극과 중첩한다. 제2 드레인 영역은, 제2 채널 영역에서 제2 소스 영역과 대향하여 연장된다. 제1 드레인 전극은, 제2 드레인 영역 및 제1 화소 전극과 연결된다.

[0036] 일례로, 제3 박막 트랜지스터는, 제3 소스 영역, 제3 게이트 전극, 제3 채널 영역 및 제3 드레인 영역을 포함한다. 제3 소스 영역은, 제2 게이트 배선의 하부에서 데이터 배선과 연결된다. 제3 게이트 전극은, 제2 게이트 배선의 일부이다. 제3 채널 영역은, 제2 수직부에서 제3 게이트 전극과 중첩한다. 제3 드레인 영역은, 제2 게이트 배선의 상부로 제3 채널 영역에서 연장된다.

[0037] 일례로, 제4 박막 트랜지스터는, 제4 소스 영역, 제4 게이트 전극, 제4 채널 영역, 제4 드레인 영역 및 제2 드레인 전극을 포함한다. 제4 소스 영역은, 제3 드레인 영역에서 수평 방향으로 연장된다. 제4 채널 영역은, 제2 수평부에서 제4 게이트 전극과 중첩한다. 제4 드레인 영역은, 제4 채널 영역에서 제4 소스 영역과 대향하여 연장된다. 제2 드레인 전극은, 제4 드레인 영역 및 제2 화소 전극과 연결된다.

[0038] 일례로, 수직부는, 데이터 배선과 중첩하여 배치되며, 양 끝단부 각각이 데이터 배선과 연결된다.

발명의 효과

[0039] 본 발명에 의한 평판 표시장치용 박막 트랜지스터 기관은, 각 화소에 보상용 박막 트랜지스터를 더 구비함으로써, 다결정 실리콘 반도체 물질을 포함하는 박막 트랜지스터의 오프-전류 특성을 보상하여, 양질의 화상 품질을 구현할 수 있다. 본 발명에 의한 액정 표시장치는, 보상 박막 트랜지스터를 구비할 때 발생할 수 있는 개구율 저하를 최소한으로 하기 위한 화소 구조를 갖는다. 따라서, 500PPI 이상의 초고 해상도를 구현하더라도, 고 개구율을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 본 발명에서는 동일한 데이터 배선이 좌우에 배치된 화소에 화상 정보를 제공하는 구조를 갖는다. 따라서, 이중 비율 데이터 구동(DRD; Double Rate Driving) 방식을 적용하여, 데이터 배선의 개수를 줄여 고속 구동을 구현할 수 있으며, 소비 전력도 절감할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0040] 도 1은 종래의 프린지 필드 방식의 액정 표시장치에 포함된 산화물 반도체 층을 갖는 평판형 표시패널을 구성하는 박막 트랜지스터 기관을 나타내는 평면도.

도 2는 도 1에 도시한 평판표시장치의 박막 트랜지스터 기관에서 절취선 I-I'선을 따라 자른 단면도.

도 3은 종래 기술에 의한 보상 박막 트랜지스터를 구비한 액정 표시장치용 박막 트랜지스터 기관의 구조를 나타내는 평면도.

도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 의한 보상 박막 트랜지스터를 구비한 액정 표시장치용 박막 트랜지스터 기관을 나타내는 평면도.

도 5는 도 4에 도시한 평판 표시장치의 박막 트랜지스터 기관에서 절취선 II-II' 선을 따라 자른 단면도.

도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 의한 보상 박막 트랜지스터를 구비한 액정 표시장치용 박막 트랜지스터 기관을 나타내는 평면도.

도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 의한 액정 표시장치의 일부를 나타내는 평면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0041] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 실질적으로 동일한 구성요소들을 의미한다. 이하의 설명에서, 본 발명과 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그 상세한 설명을 생략한다.

[0042] <제1 실시 예>

[0043] 이하, 도 4 및 5를 참조하여, 본 발명의 제1 실시 예에 대하여 설명한다. 도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 의한 보상 박막 트랜지스터를 구비한 액정 표시장치용 박막 트랜지스터 기관을 나타내는 평면도이다. 도 5는 도 4에 도시한 평판 표시장치의 박막 트랜지스터 기관에서 절취선 II-II' 선을 따라 자른 단면도이다. 도 4 및 5는 보상 박막 트랜지스터를 포함하면서, 400PPI 정도의 고 해상도 액정 표시장치를 구현하기 위한 박막 트랜지스터 기관을 나타내는 도면들이다.

[0044] 본 발명의 제1 실시 예에 의한, 박막 트랜지스터 기관은 하부 기관(SUB) 위에 중간 절연막(IN)을 사이에 두고 교차하는 게이트 배선(GL) 및 데이터 배선(DL)에 의해 화소 영역이 정의된다. 화소 영역에는 프린지 필드를 형성하도록 제2 보호막(PAS2)을 사이에 두고 형성된 화소 전극(PXL)과 공통전극(COM)을 구비한다. 공통전극(COM)은 화소 영역의 대부분을 모두 덮도록 형성되고, 화소 전극(PXL)은 평행한 다수 개의 띠 모양으로 형성될 수 있다. 400PPI 정도의 고 해상도용 박막 트랜지스터 기관에서는 화소의 크기가 상당히 작아진다. 따라서, 화소 전극(PXL)이 두 세개 정도의 선분들로만 이루어질 수도 있다.

[0045] 각 화소 영역에는 구동 박막 트랜지스터(T1)가 하나씩 배치된다. 또한, 구동 박막 트랜지스터(T1)에는 오프-전류 특성을 보완하기 위한 보상 박막 트랜지스터(T2)가 배치된다. 구동 박막 트랜지스터(T1)의 드레인 전극(D1)은 보상 박막 트랜지스터(T2)의 소스 전극(S2)과 연결된다.

[0046] 직렬로 연결된 구동 박막 트랜지스터(T1)와 보상 박막 트랜지스터(T2)를 포함하는 박막 트랜지스터 기관의 구조

를 좀 더 구체적으로 설명한다. 기판(SUB) 위에 가로 방향으로 진행되는 게이트 배선(GL)들과 세로 방향으로 진행되는 데이터 배선(DL)들이 교차하는 구조로 매트릭스 방식의 화소 영역이 정의된다.

- [0047] 제1 실시 예에서는, 화소 영역에서 발광 영역의 비율을 높이기 위해, 게이트 전극을 게이트 배선에서 분기한 형태로 형성하지 않고, 게이트 배선의 일부를 이용하여 형성한다. 즉, 반도체 층(SE)을 게이트 배선(GL)과 중첩하도록 형성함으로써 박막 트랜지스터를 구성한다.
- [0048] 예를 들어, 반도체 층(SE)을 데이터 배선(DL)의 일부와 접촉하면서, 데이터 배선(DL)과 중첩하여 연장되어, 게이트 배선(GL)과 교차하도록 연장된다. 그러면, 게이트 배선(GL) 및 데이터 배선(DL)과 중첩하는 반도체 층(SE)의 일부가 구동 박막 트랜지스터(T1)의 채널 층(A1)으로 정의된다. 그리고 게이트 배선(GL)과 평행하게 게이트 배선(GL)의 아래에 정의된 화소 영역으로 꺾어진 후, 데이터 배선(DL)과 평행하게 연장되어 게이트 배선(GL)과 다시 중첩하면서 게이트 배선(GL)의 위에 정의된 화소 영역으로 연장된다. 그러면, 게이트 배선(GL)과 중첩되는 반도체 층(SE)의 타부가 보상 박막 트랜지스터(T2)의 채널 층(A2)으로 정의된다.
- [0049] 좀 더 상세히 설명한다. 기판(SUB) 위에 반도체 층(SE)이 형성되어 있다. 반도체 층(SE)은 나중에 형성될 데이터 배선(DL)의 일부를 따라서 진행되는 제1 수직 선분부(VS1)를 갖는다. 제1 수직 선분부(VS1)는 나중에 형성될 게이트 배선(GL)을 중심으로 윗단 화소 영역에서 아랫단 화소 영역까지 연장되어 배치된다. 반도체 층(SE)은 제1 수직 선분부(VS1)의 아래 끝단부에서 아랫단 화소 영역으로 꺾이어 연장된 수평 선분부(HS)를 갖는다. 그리고, 반도체 층(SE)은 수평 선분부(HS)의 아랫단 화소 영역에서 게이트 배선(GL)을 타고 넘어 윗단 화소 영역으로 연장된 제2 수직 선분부(VS2)를 갖는다.
- [0050] 반도체 층(SE)이 형성된 기판(SUB) 전체 표면 위에는, 게이트 절연 물질과 게이트 금속물질을 도포하고 패터닝하여 형성된, 게이트 절연막(GI) 및 게이트 배선(GL)이 배치된다. 특히, 게이트 배선(GL)은, 각 화소당, 반도체 층(SE)과 교차하는 영역이 두 부분을 갖는다. 이렇게 반도체 층(SE)과 중첩하는 게이트 배선(GL)의 부분들을 편의상 게이트 전극(G1, G2)으로 정의한다. 반도체 층(SE)의 제1 수직 선분부(VS1)와 중첩하는 게이트 배선(GL)은 구동 박막 트랜지스터의 게이트 전극(G1)으로 정의된다. 또한, 반도체 층(SE)의 제2 수직 선분부(VS2)와 중첩하는 게이트 배선(GL)은 보상 박막 트랜지스터의 게이트 전극(G2)으로 정의된다.
- [0051] 반도체 층(SE)은 게이트 절연막(GI) 및 게이트 배선(GL)과 중첩하는 영역과 그렇지 않고 노출되는 영역으로 구분된다. 게이트 배선(GL)과 중첩하지 않고 노출된 영역에는 불순물을 주입하여 도체화할 수 있다. 그 결과, 게이트 배선(GL)과 중첩하는 반도체 층(SE)은 채널 영역(A1, A2)으로 정의된다. 즉, 구동 게이트 전극(G1)과 중첩하는 반도체 층(SE)은 구동 박막 트랜지스터 채널 영역(A1)으로, 보상 게이트 전극(G2)과 중첩하는 반도체 층(SE)은 보상 박막 트랜지스터 채널 영역(A2)으로 정의된다.
- [0052] 게이트 전극들(G1, G2)을 포함하는 게이트 배선(GL)이 형성된 기판(SUB) 전체 표면 위에는 중간 절연막(IN)이 도포되어 있다. 이때, 게이트 배선(GL)이 형성되지 않은 도체화된 반도체 층(SE)의 영역들은 소스 영역 및 드레인 영역으로 정의된다. 구체적으로 설명하면, 구동 박막 트랜지스터 채널 영역(A1)의 일측부이며 반도체 층(SE)의 시작부는 구동 박막 트랜지스터 소스 영역(SA1)으로, 구동 박막 트랜지스터 채널 영역(A1)의 타측부는 구동 박막 트랜지스터 드레인 영역(DA1)으로 정의된다. 한편, 보상 박막 트랜지스터 채널 영역(A2)의 일측부이며, 구동 박막 트랜지스터 드레인 영역(D1)에서 연장된 부분은 보상 박막 트랜지스터 소스 영역(SA2)으로, 보상 박막 트랜지스터 채널 영역(A2)의 타측부는 보상 박막 트랜지스터 드레인 영역(DA2)으로 정의된다. 특히, 구동 박막 트랜지스터 드레인 영역(DA1)과 보상 박막 트랜지스터 소스 영역(SA2)은 반도체 층(SE)의 수평 선분부(HS)를 구성한다.
- [0053] 중간 절연막(IN)에는, 구동 박막 트랜지스터 소스 영역(SA1)의 일부를 노출하는 소스 콘택홀(SH)과, 보상 박막 트랜지스터 드레인 영역(DA2)의 일부를 노출하는 드레인 콘택홀(DH)을 구비한다. 중간 절연막(IN) 위에는 소스-드레인 금속 물질로 형성된 데이터 배선(DL)이 배치되어 있다. 데이터 배선(DL)은 게이트 배선(GL)과 직교하도록 배치된다. 특히, 화소 영역에서 비 표시 영역의 비율을 줄이기 위해, 소스 전극을 별도로 형성하지 않고, 데이터 배선(DL)의 일부를 소스 전극으로 활용한다. 즉, 소스 콘택홀(SH)을 통해 노출된 반도체 층(SE)의 구동 박막 트랜지스터 소스 영역(SA1)과 접촉하는 데이터 배선(DL)의 일부가 구동 박막 트랜지스터 소스 전극(S1)이 된다. 한편, 드레인 콘택홀(DH)을 통해서 노출된 반도체 층(SE)의 보상 박막 트랜지스터 드레인 영역(DA2)과 접촉하는 드레인 전극(D2)은 별도로 배치된다. 드레인 전극(D2)은 화소 영역에서 하단부에 일정한 크기를 갖고 형성되어 있다.
- [0054] 그 후, 구동 박막 트랜지스터(T1) 및 보상 박막 트랜지스터(T2)를 덮는 제1 보호막(PAS1)이 기판(SUB) 전체 표

면에 도포되어 있다. 제1 보호막(PAS1) 위에는 기관(SUB) 전체 표면 대부분을 덮도록 공통 전극(COM)이 배치된다. 공통 전극(COM)의 면 저항을 낮추며, 하부에 배치된 박막 트랜지스터들(T1, T2) 및 각종 배선들과의 전기적 간섭을 차폐할 수 있도록 가급적 기관(SUB) 전체 면적의 대부분을 덮는 구조를 갖는 것이 바람직하다. 공통 전극(COM) 위에는 화소 전극(PXL)을 형성하여야 하는데, 화소 전극(PXL)과 보상 박막 트랜지스터 드레인 전극(D2)을 연결하기 위한 화소 콘택홀(PH) 부분을 제외한 거의 모든 영역을 덮도록, 공통 전극(COM)을 형성하는 것이 바람직하다.

[0055] 공통 전극(COM) 위에는 기관(SUB) 전체 표면을 덮는 제2 보호막(PAS2)이 도포되어 있다. 제2 보호막(PAS2) 및 제1 보호막(PAS1)의 일부를 제거하여 보상 박막 트랜지스터 드레인 전극(D2) 일부를 노출하는 화소 콘택홀(PH)이 형성되어 있다. 화소 콘택홀(PH)은 드레인 콘택홀(DH)로부터 화소 영역 내측으로 일정 거리 이격된 위치에 형성된다. 제2 보호막(PAS2) 위에는 화소 콘택홀(PH)을 통해 보상 박막 트랜지스터 드레인 전극(D2)과 연결되는 화소 전극(PXL)이 형성되어 있다. 공통 전극(COM)과 화소 전극(PXL) 사이에 프린지 필드를 형성하도록 하기 위해, 화소 전극(PXL)은 다수 개의 선분 형태로 형성하는 것이 바람직하다.

[0056] 본 발명의 제1 실시 예에 의한 박막 트랜지스터 기관은, 300 내지 400PPI 정도의 고 해상도용 액정 표시장치에 적용할 수 있다. 400PPI 전후의 고 해상도를 구현하기 위해서는 화소 영역의 크기가 상당히 작아진다. 예를 들어, 화소 전극(PXL)을 구성하는 선분은 2개 혹은 3개의 수직 선분들을 구비할 수 있다.

[0057] 제1 실시 예에 의한 박막 트랜지스터 기관의 구조는 화소 영역 내에서 비 표시 영역이 차지하는 비율을 줄여서 고 해상도용 액정표시장치에 적용할 수 있었다. 그러나 제1 실시 예와 같은 구동 박막 트랜지스터에 직렬로 연결된 보상 박막 트랜지스터를 더 구비한 박막 트랜지스터 기관을 500PPI 이상의 초고 해상도용 액정 표시장치에 그대로 적용하는 데에는 충분하지 않다. 500PPI를 넘어 800PPI 정도의 초고 해상도 액정 표시장치에 적용할 수 있도록 비 표시 영역의 비율을 극소화한 박막 트랜지스터 기관의 구조가 필요하다. 이하의 설명에서는 제1 실시 예에서 제시한 기본 개념을 더욱 확장하여 비 표시 영역을 극소화함으로써 500 내지 800PPI 정도의 초고 해상도를 구현할 수 있는 박막 트랜지스터 기관의 구조를 제안한다.

[0058] <제2 실시 예>

[0059] 이하, 도 6을 참조하여, 본 발명의 제2 실시 예를 설명한다. 도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 의한 보상 박막 트랜지스터를 구비한 액정 표시장치용 박막 트랜지스터 기관을 나타내는 평면도이다.

[0060] 도 6을 참조하면, 제2 실시 예에 의한 박막 트랜지스터 기관은, 기관(SUB) 위에 배치된 제1 게이트 배선(GLn), 제2 게이트 배선(GLn+1) 및 데이터 배선(DLn)을 포함한다. 제1 게이트 배선(GLn)과 제2 게이트 배선(GLn+1)은 서로 인접하여 기관(SUB)의 가로 방향으로 평행하게 배치된다. 데이터 배선(DLn)은 제1 게이트 배선(GLn)과 제2 게이트 배선(GLn+1)들을 가로 질러 기관(SUB)의 세로 방향으로 진행한다.

[0061] 데이터 배선(DLn)을 기준으로 우측부에 제1 화소 영역(Pn)이 좌측부에는 제2 화소 영역(Pn+1)이 배치되어 있다. 여기서, 제1 및 제2는 설명의 편의상 지정한 용어이다. 제1 화소 영역(Pn)에는 제1 박막 트랜지스터(T1), 제2 박막 트랜지스터(T2), 및 제1 화소 전극(PXLn)이 배치된다. 제2 화소 영역(Pn+1)에는 제3 박막 트랜지스터(T3), 제4 박막 트랜지스터(T4), 및 제2 화소 전극(PXLn+1)이 배치된다.

[0062] 이웃하며 서로 근접하여 평행하게 배치된 제1 게이트 배선(GLn)과 제2 게이트 배선(GLn+1) 사이에 제1 박막 트랜지스터(T1), 제2 박막 트랜지스터(T2), 제3 박막 트랜지스터(T3) 및 제4 박막 트랜지스터(T4)들이 배치되어 있다. 특히, 이들 박막 트랜지스터들은 십자(+) 모양의 반도체 층을 공유함으로써, 형성된다.

[0063] 좀 더 상세히 설명하면, 십자형 반도체 층은, 데이터 배선(DLn)과 중첩하는 수직부를 포함한다. 수직부는, 제1 게이트 배선(GLn) 및 제2 게이트 배선(GLn+1)과 모두 중첩하는 선분 형상을 갖는다. 즉, 제1 게이트 배선(GLn)의 상변에서 시작하여, 제1 게이트 배선(GLn) 및 제2 게이트 배선(GLn+1)을 가로지르고, 제2 게이트 배선(GLn+1)의 하변에서 끝나는 선분 형상을 갖는다. 특히, 양끝단 각각은, 제1 게이트 배선(GLn)의 상변에서, 그리고 제2 게이트 배선(GLn+1)의 하변에서 각각 데이터 배선(DLn)과 연결되어 있다.

[0064] 또한, 십자형 반도체 층은, 제1 게이트 배선(GLn)과 제2 게이트 배선(GLn+1)의 사이에서, 데이터 배선(DLn)과 중첩하는 수평부를 포함한다. 수평부는, 데이터 배선(DLn)의 좌측에서 시작하여, 데이터 배선(DLn)을 가로지르고, 데이터 배선(DLn)의 우측에서 끝나는 선분 형상을 갖는다. 특히, 데이터 배선(DLn)의 우측에 배치된 우측 선분부는, 제1 게이트 배선(GLn)에서 아래 방향으로 분기하는 제2 게이트 전극(G2)을 가로질러 배치된다. 또한, 데이터 배선(DLn)의 좌측에 배치된 좌측 선분부는, 제2 게이트 배선(GLn+1)에서 위 방향으로 분기하는 제

4 게이트 전극(G4)을 가로질러 배치된다.

- [0065] 십자형 반도체 층은, 제1 게이트 배선(GLn)과 중첩하는 제1 채널 영역(A1), 제2 게이트 전극(G2)과 중첩하는 제2 채널 영역(A2), 제2 게이트 배선(GLn+1)과 중첩하는 제3 채널 영역(A3), 그리고 제4 게이트 전극(G4)과 중첩하는 제4 채널 영역(A4)을 포함한다. 여기서, 제1 게이트 배선(GLn)에서 제1 채널 영역(A1)과 중첩하는 영역은 제1 게이트 전극(G1)이, 그리고 제2 게이트 배선(GLn+1)에서 제3 채널 영역(A3)과 중첩하는 영역은 제3 게이트 전극(G3)이 된다.
- [0066] 십자형 반도체 층의 수직부는, 제1 수직부와 제2 수직부를 포함한다. 제1 수직부는, 제1 채널 영역(A1)을 포함하고, 제2 수직부는 제3 채널 영역(A3)을 포함한다. 즉, 제1 수직부는, 제1 박막 트랜지스터(T1)을 구성하며, 제2 수직부는 제3 박막 트랜지스터(T3)를 구성한다.
- [0067] 십자형 반도체 층의 수직부에서, 제1 채널 영역(A1)을 중심으로 하여, 제1 게이트 배선(GLn)의 상변으로 연장된 부분은 제1 소스 영역(SA1)이고, 하변으로 연장된 부분은 제1 드레인 영역(DA1)이다. 또한, 제3 채널 영역(A3)을 중심으로 하여, 제2 게이트 배선(GLn+1)의 하변으로 연장된 부분은 제3 소스 영역(SA3)이고, 상변으로 연장된 부분은 제3 드레인 영역(DA3)이다.
- [0068] 십자형 반도체 층의 수평부에서, 제2 채널 영역(A2)을 중심으로 하여, 제2 게이트 전극(G2)의 좌측으로 연장된 부분은 제2 소스 영역(SA2)이고, 우측으로 연장된 부분은 제2 드레인 영역(DA2)이다. 또한, 제4 채널 영역(A4)을 중심으로 하여, 제4 게이트 전극(G4)의 우측으로 연장된 부분은 제4 소스 영역(SA4)이고, 좌측으로 연장된 부분은 제4 드레인 영역(DA4)이다.
- [0069] 십자형 반도체 층의 수평부는, 제1 수평부와 제2 수평부를 포함한다. 제1 수평부는, 제2 채널 영역(A2)을 포함하고, 제2 수평부는 제4 채널 영역(A4)을 포함한다. 즉, 제1 수평부는 제2 박막 트랜지스터(T2)를 구성하며, 제2 수평부는 제4 박막 트랜지스터(T4)를 구성한다.
- [0070] 이와 같은 십자형 구조로 인해, 십자형의 정 중앙 영역은, 제1 드레인 영역(DA1), 제2 소스 영역(SA2), 제3 드레인 영역(DA3) 및 제4 소스 영역(SA4)이 공유하는 영역으로서 서로 연결되어 있다. 도 6에서는 설명의 편의상 십자형 반도체에서 제1 수평부와 제2 수평부가 일직선 상에 배치된 구조로 설명하였다. 하지만, 경우에 따라서는 제1 수평부와 제2 수평부가 일직선 상에 배치되지 않고, 엇갈려 배치될 수 있다. 또한, 필요하다면, 십자형 반도체 층의 중앙부가 모두 연결되지 않고, 제1 수직부는 제1 수평부와만 연결되고, 제2 수직부는 제2 수평부와만 연결된 구조를 가질 수도 있다.
- [0071] 십자형 반도체 층의 수직부가 직접 데이터 배선(DLn)에 연결된 구조를 가짐으로써, 별도의 소스 전극들을 구비하지 않는다. 반면에 드레인 영역들에는 드레인 전극들이 각각 연결되어 있다. 예를 들어, 제1 드레인 영역(DA1)은 제1 드레인 전극(D1)에, 제2 드레인 영역(DA2)은 제2 드레인 전극(D2)에, 제3 드레인 영역(DA3)은 제3 드레인 전극(D3)에, 그리고 제4 드레인 영역(DA4)은 제4 드레인 전극(D4)에 연결되어 있다. 또한, 제2 드레인 전극(D2)에는 제1 화소 전극(PXLn)이 연결되고, 제4 드레인 전극(D4)에는 제2 화소 전극(PXLn+1)이 연결된다.
- [0072] 제2 실시 예에 의한 십자형 반도체 층에 배치된 네 개의 채널 영역들에 의해 박막 트랜지스터들이 정의된다. 즉, 제1 박막 트랜지스터(T1)는, 제1 소스 영역(SA1), 제1 게이트 전극(G1), 제1 채널 영역(A1) 및 제1 드레인 영역(DA1)을 포함한다. 제2 박막 트랜지스터(T2)는, 제2 소스 영역(SA2), 제2 게이트 전극(G2), 제2 채널 영역(A2), 제2 드레인 영역(DA2) 및 제1 드레인 전극(Dn)을 포함한다. 제3 박막 트랜지스터(T3)는, 제3 소스 영역(SA3), 제3 게이트 전극(G3), 제3 채널 영역(A3) 및 제3 드레인 영역(DA2)을 포함한다. 그리고 제4 박막 트랜지스터(T4)는, 제4 소스 영역(SA4), 제4 게이트 전극(G4), 제4 채널 영역(A4), 제4 드레인 영역(DA4) 및 제2 드레인 전극(Dn+1)을 포함한다.
- [0073] 제1 게이트 배선(GLn)에 게이트 신호(혹은, 스캔 신호)가 인가되면, 제1 게이트 배선(GLn)에 연결된 제1 게이트 전극(G1) 및 제2 게이트 전극(G2)에 게이트 신호가 전달된다. 그러면, 제1 채널 영역(A1)과 제2 채널 영역(A2)이 열린다. 이 때, 데이터 배선(DLn)에 데이터 신호는 데이터 배선(DLn)에 연결된 십자형 반도체 층의 제1 채널 영역(A1)과 제2 채널 영역(A2)을 순차적으로 통과하여, 제1 드레인 전극(Dn)에 전달된다. 그 결과, 제1 드레인 전극(Dn)에 연결된 제1 화소 전극(PXLn)에 데이터 전압이 인가된다.
- [0074] 마찬가지로, 제2 게이트 배선(GLn+1)에 게이트 신호(혹은, 스캔 신호)가 인가되면, 제2 게이트 배선(GLn+1)에 연결된 제3 게이트 전극(G3) 및 제4 게이트 전극(G4)에 게이트 신호가 전달된다. 그러면, 제3 채널 영역(A3)과 제4 채널 영역(A4)이 열린다. 이 때, 데이터 배선(DLn)에 데이터 신호는 데이터 배선(DLn)에 연결된 십자형 반도체 층의 제3 채널 영역(A3)과 제4 채널 영역(A4)을 순차적으로 통과하여, 제2 드레인 전극(Dn+1)에 전달된다.

그 결과, 제2 트레인 전극(Dn+1)에 연결된 제2 화소 전극(PXLn+1)에 데이터 전압이 인가된다.

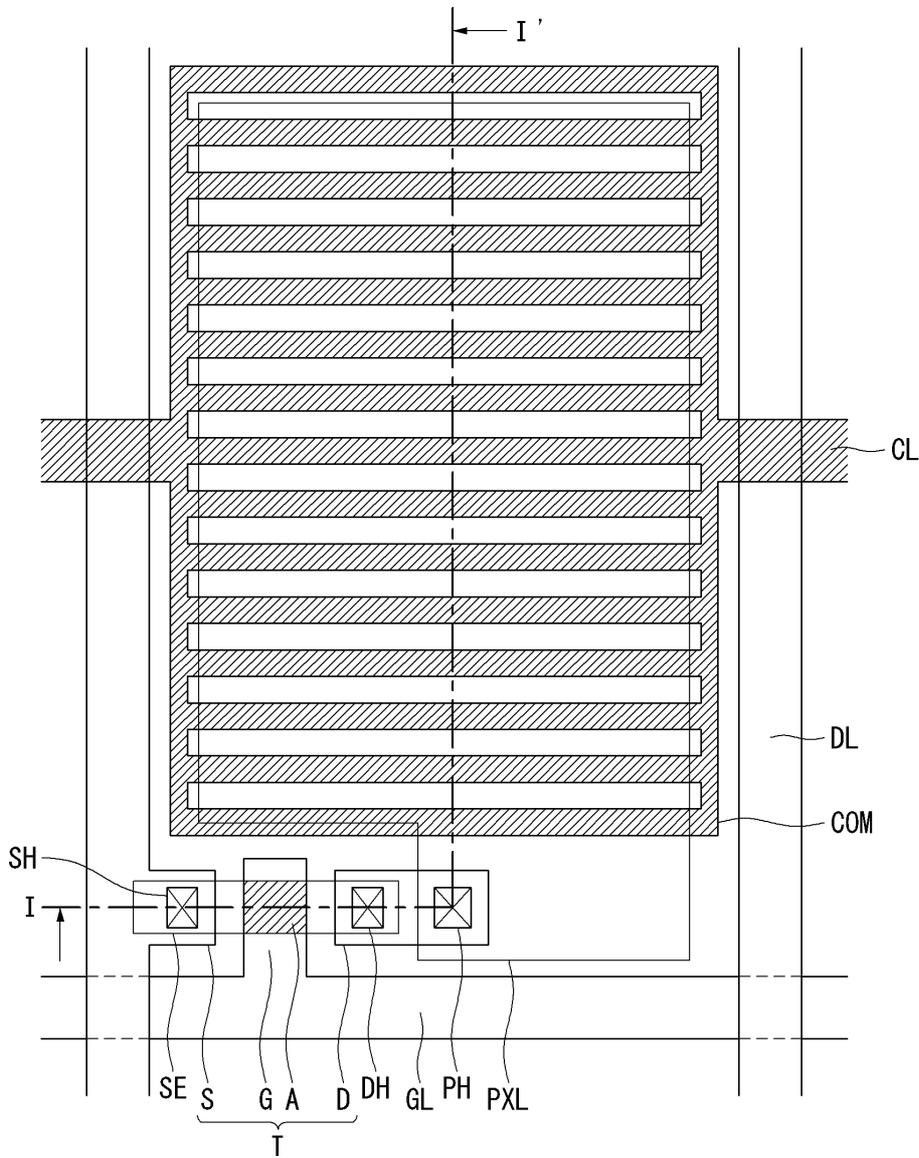
- [0075] 도 6에 도시한 제2 실시 예에 의한 박막 트랜지스터 기관에서는, 반도체 층이 데이터 배선(DLn)과 중첩하여 배치되고, 좌우에 배치된 두 개의 화소 전극에 모두 연결된 구조를 갖는다. 다만, 게이트 배선에 따라서 데이터 전압이 인가되는 화소 전극이 선택된다. 따라서, 단일 화소 영역 내에서 박막 트랜지스터들이 차지하는 면적을 최소화 할 수 있다. 즉, 500PPI를 넘어 800PPI이상의 초고해상도 구조에서 개구율을 극대화할 수 있는 구조를 제공한다.
- [0076] 이하, 도 7을 더 참조하여, 본 발명의 제2 실시 예에 의한 박막 트랜지스터 기관의 전체적인 구조를 설명한다. 도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 의한 액정 표시장치의 일부를 나타내는 평면도이다.
- [0077] 도 7을 참조하면, 제2 실시 예에 의한 박막 트랜지스터 기관은, 매트릭스 방식으로 배열된 다수 개의 화소 영역(PA)들을 포함한다. 하나의 화소 영역(PA)은 발광 영역(EA)을 포함한다. 화소 영역(PA)에서 발광 영역(EA)을 제외한 나머지 영역은 비 발광 영역이다.
- [0078] 화소 영역(PA)은 이웃하는 두 개의 게이트 배선들과, 게이트 배선들과 교차하는 데이터 배선으로 둘러싸여 있다 포함한다. 특히, 이웃하는 두 개의 데이터 배선들 사이에 두 개의 화소 영역이 배치된다. 따라서, 제1 실시 예와 비교했을 때, 데이터 배선의 갯수가 1/2로 줄어든다.
- [0079] 즉, 도 7에 도시한 박막 트랜지스터 기관은, 이중 비율 데이터 구동(DRD; Double Rate Driving) 방식을 구현할 수 있는 구조이다. 데이터 배선의 갯수를 1/2로 줄여, 데이터 구동부의 구성을 간소화할 수 있다. 또한, 데이터 구동부가 필요로 하는 구동 전력도 줄일 수 있으며, 고속 구동이 가능하다.
- [0080] 반면에, 게이트 배선이 2배 증가한다. 게이트 배선이 증가함으로써 개구율이 줄어들 수 있다. 하지만, 가로 방향으로 진행되는 게이트 배선의 갯수가 세로 방향으로 진행되는 데이터 배선의 갯수보다 훨씬 적기 때문에, 게이트 배선 수의 증가에 의한 개구율 저하는 상대적으로 적다. 또한, 이웃하는 게이트 배선들 사이에 게이트 전극이 대향하여 분기한 구조를 가짐으로써, 게이트 배선의 증가에 따른 비 발광 영역의 증가는 훨씬 줄일 수 있다. 즉, 제1 실시 예와 비교해서, 게이트 배선에 의한 비 발광 영역의 증가는 그리 크지않다. 결론적으로, 데이터 배선의 갯수를 1/2로 줄임으로써, 개구율을 증가할 수 있다.
- [0081] 또한, 데이터 배선이 1/2로 줄어, 데이터 배선이 있던 위치에 다른 배선들을 추가로 배치할 수도 있다. 예를 들어, 수직 게이트 배선을 배치하여, 표시 패널의 좌측 및/또는 우측에 배치하는 게이트 구동부를 데이터 구동부와 동일한 위치인 패널의 상변 혹은 하변에 배치할 수 있다. 이 경우, 좌/우 베젤을 극소화할 수 있다는 장점을 얻을 수 있다.
- [0082] 또는, 터치 패널을 내장한 표시장치에 적용할 경우, 터치 라우팅 배선 및/또는 연결 배선을 데이터 배선이 있었던 위치에 배치할 수 있다. 이 경우, 개구율 저하를 최소화하면서, 터치 패널이 내장된 평판 표시장치를 제공할 수 있다는 장점을 얻을 수 있다.
- [0083] 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 아니하는 범위 내에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구 범위에 의해 정해져야만 할 것이다.

부호의 설명

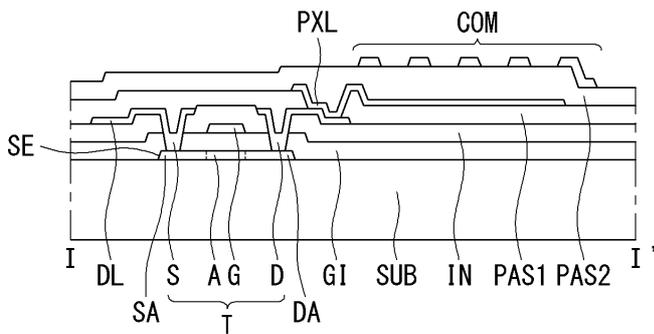
- [0084] T: 박막 트랜지스터 SUB: 기관
- GL: 게이트 배선 CL: 공통 배선
- DL: 데이터 배선 PXL: 화소 전극
- COM: 공통 전극 T1: 구동 박막 트랜지스터
- T2: 보상 박막 트랜지스터

도면

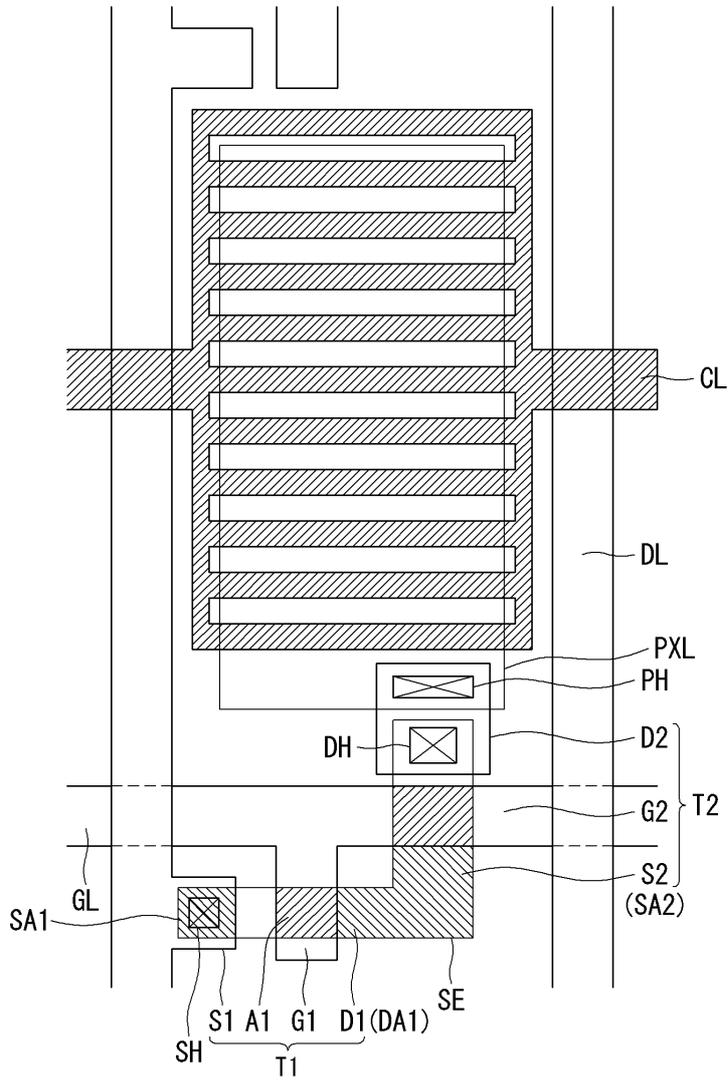
도면1



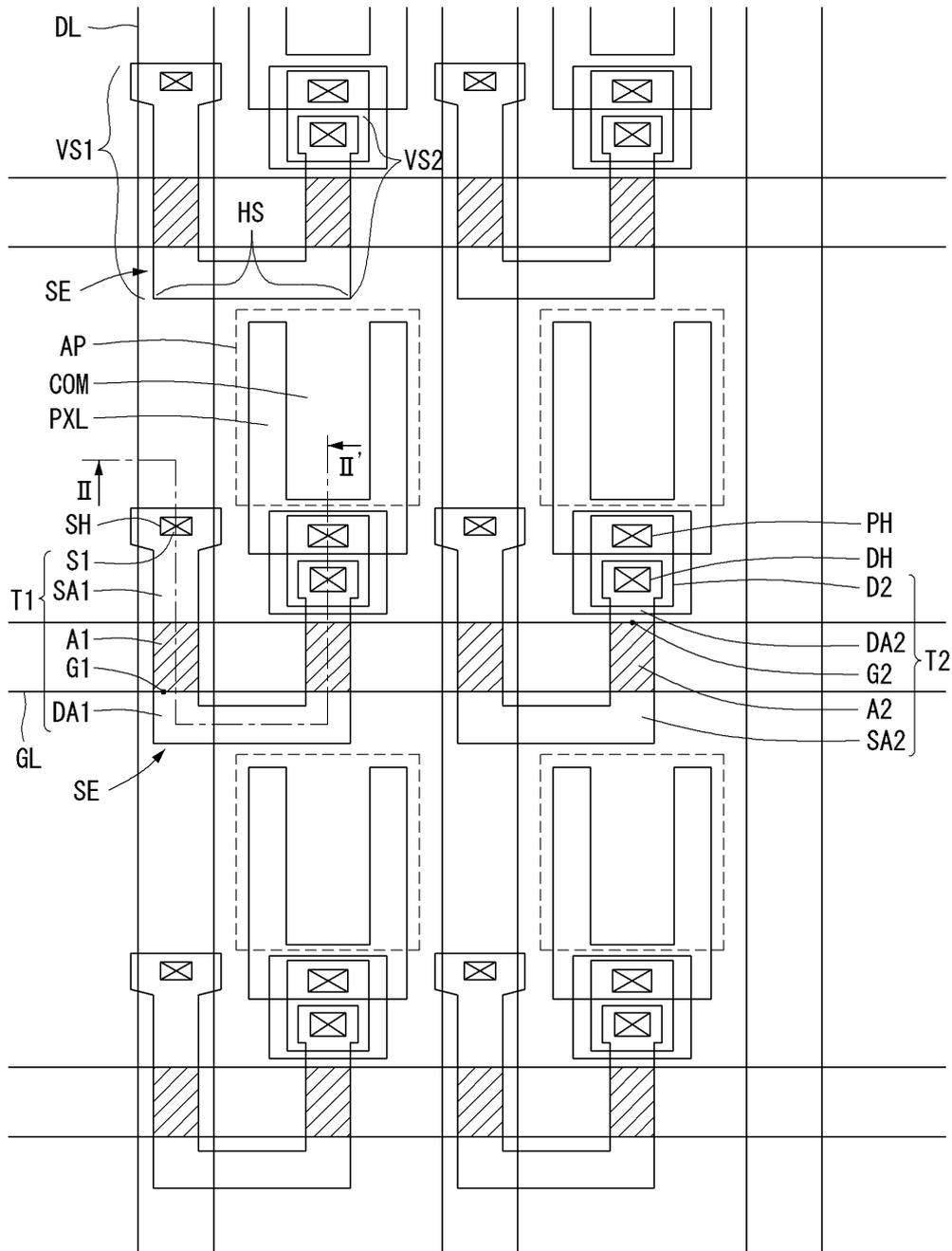
도면2



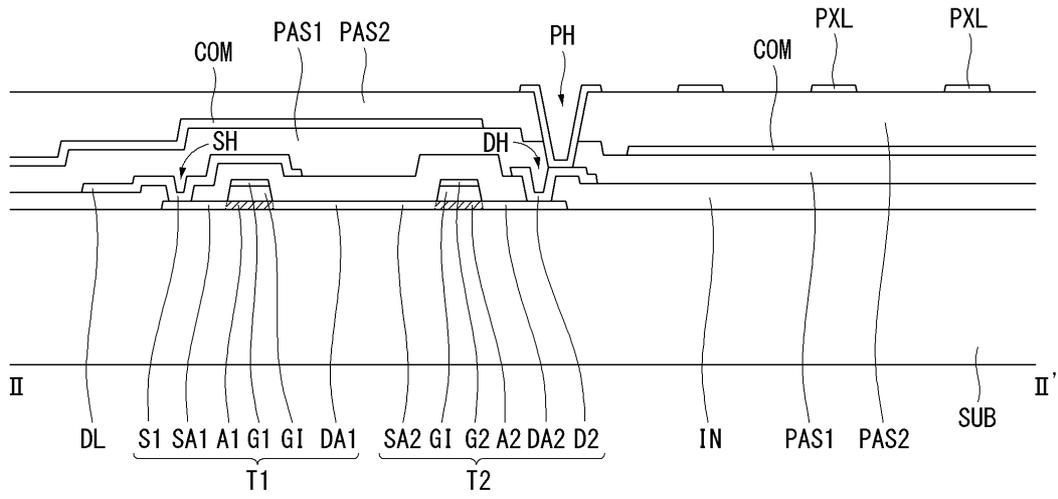
도면3



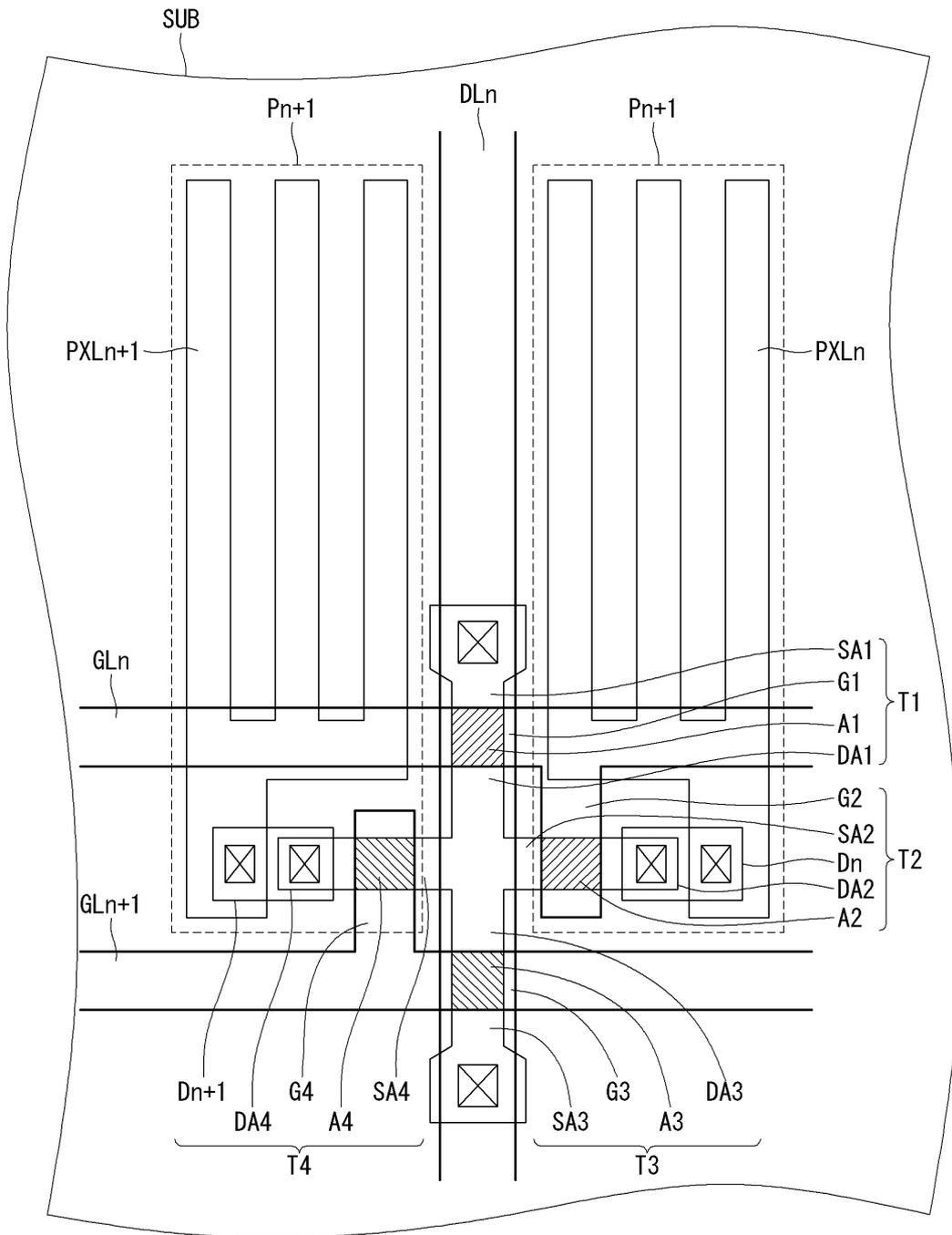
도면4



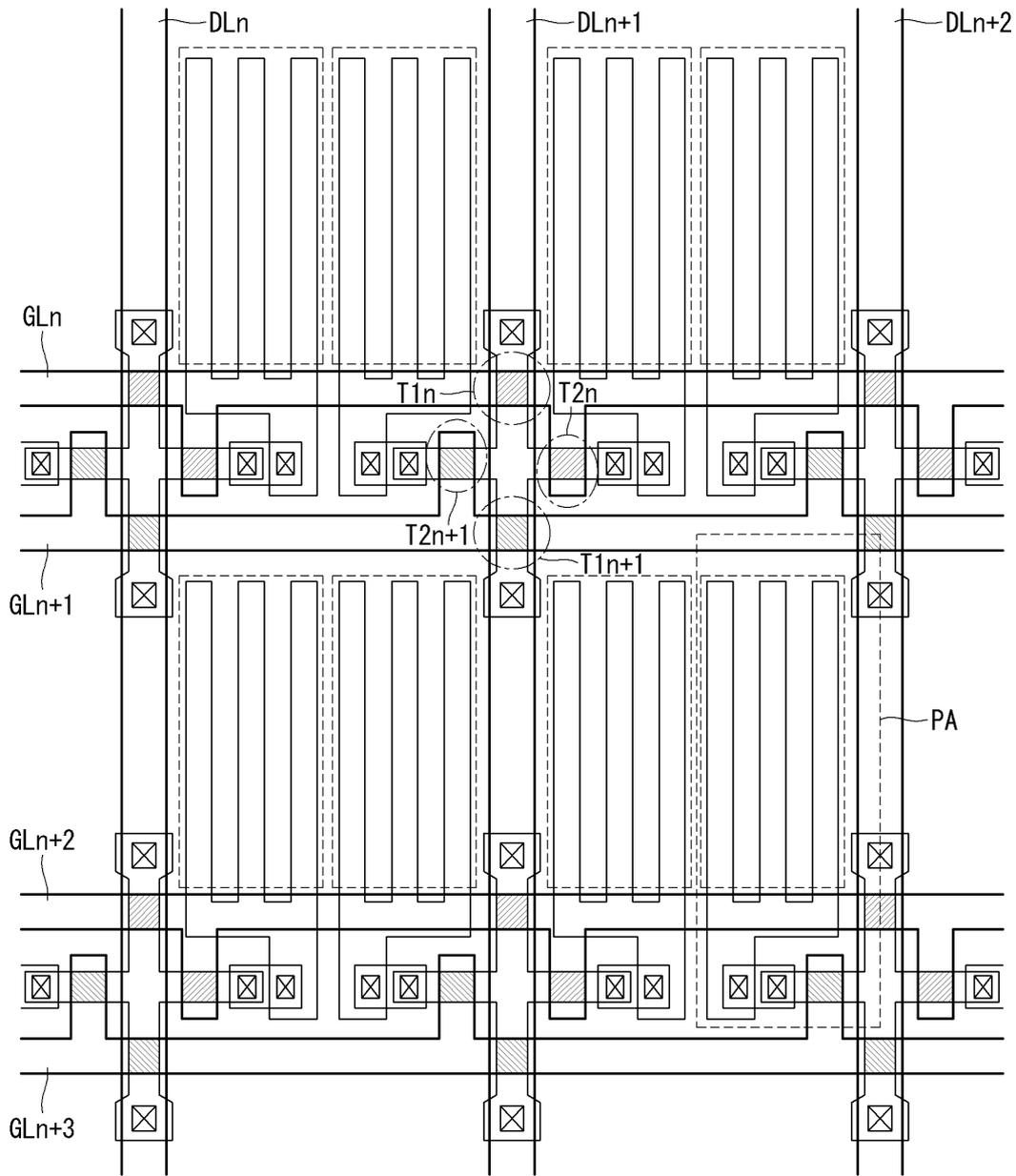
도면5



도면6



도면7



专利名称(译)	超高分辨率液晶显示器		
公开(公告)号	KR1020180047614A	公开(公告)日	2018-05-10
申请号	KR1020160143998	申请日	2016-10-31
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	KIM WON DOO 김원두 KIM KA KYUNG 김가경		
发明人	김원두 김가경		
IPC分类号	G02F1/1368 G02F1/1343 G02F1/1362 H01L29/786		
CPC分类号	G02F1/1368 G02F1/136286 G02F1/13624 G02F1/134309 H01L29/786 G02F2201/123		

摘要(译)

超高分辨率液晶显示装置本发明涉及一种超高分辨率液晶显示装置，还包括用于每像素补偿的薄膜晶体管。根据本发明的超高分辨率液晶显示装置包括第一栅极布线，第二栅极布线，数据布线，第二栅电极，第四栅电极，十字形半导体层，第一像素电极和第二像素电极的。第一栅极布线和第二栅极布线彼此相邻布置。数据布线穿过第一栅极布线和第二栅极布线。十字形半导体层包括垂直部分和水平部分。垂直部分从第一栅极布线的上部延伸到第二栅极布线的下部。水平部分从垂直部分的中心延伸穿过第一栅电极和第二栅电极。

